

Samsung anuncia sus módulos de DDR4 de 32 GB



Samsung presentó a finales de mayo el primer módulo de memoria DDR4 para portátil con una capacidad de 32 GB. Esto duplica el máximo actual de 16 GB, gracias al uso de chips de memoria de mayor capacidad en cada módulo. Unos meses después, la compañía ha anunciado el **primer módulo de memoria DDR4 de 32 GB de capacidad**, usando chips de alta capacidad.

Con esto duplica la capacidad actual, y abre la puerta a sistemas con más RAM total en el sector generalista. Si bien las placas base con cuatro bancos de memoria actualmente solo llegan a los 64 GB en total –cuatro módulos de 16 GB–, usando estos módulos abre las puertas a tener 128 GB, y los sistemas de entusiastas con ocho bancos de memoria podrían alcanzar los 256 GB. Solo hace falta que se valide el correcto funcionamiento de los módulos de 32 GB en las placas base correspondientes.

Estos módulos funcionan a una velocidad de 2667 MHz, con unas latencias que probablemente sean el mínimo de 17-17-17 en esta primera generación de módulos de 32 GB. Funcionan a un voltaje de 1.2 V, usando dieciséis chips de 16 Gb (2 GB) fabricados con uno de los procesos en la órbita de los 10 nm de Samsung. Estarán disponibles inicialmente para ensambladores de PC.

Fuente: geektopia.